المراقع المراقع

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-149812

(P2003-149812A) (43)公開日 平成15年5月21日(2003.5.21)

(51) Int. C1. 7 G03F 7/039 7/004 H01L 21/027	識別記号 601 501	F I
		審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全62頁)
(21)出願番号	特願2001-343029(P2001-343029)	(71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(22) 出願日	平成13年11月8日(2001.11.8)	(72)発明者 児玉 邦彦 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(74)代理人 100105647 弁理士 小栗 昌平 (外4名)
		F ターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AB14 AB16 AC03 AC08 AD03 BE07 BE10 BG00 CB08 CB14 CB41 CC04 CC20
		FA17

(54) 【発明の名称】ポジ型感光性組成物

(57) 【要約】

【課題】 解像力に優れ、露光から後加熱までの経時に よる性能変化が殆どなくプロセス許容性に優れ、且つ疎 密依存性に優れたポジ型感光性組成物を提供する。

【解決手段】 (A) 活性光線又は放射線の照射により、特定の芳香族スルホン酸を発生する化合物及び(B) 特定の基を含有する繰り返し単位を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解度が増大する樹脂を含有することを特徴とするポジ型感光性組成物。

【特許請求の範囲】

ķ

【請求項1】 (A) 活性光線又は放射線の照射によ り、少なくとも1つのフッ素原子又は少なくとも1つの フッ素原子を有する基で置換された芳香族スルホン酸を 発生する化合物及び(B)下記一般式(1-1)~(1 -5)の少なくともいずれかで表される基を含有する繰 り返し単位を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現 像液中での溶解度が増大する樹脂を含有することを特徴 とするポジ型感光性組成物。

1

【化1】

[(£ 1)]

$$R_1$$
 R_2
 R_4
 R_5
 R_4
 R_5
 R_5
 R_1
 R_4
 R_5
 R_5
 R_7
 R_8
 R_8
 R_9
 R

一般式(1-1)~(1-5)に於いて、R,~R,は、 同じでも異なっていてもよく、水素原子、水酸基、カル ボキシル基又は置換基を有していてもよい、アルキル 基、シクロアルキル基、アルコキシカルボニル基若しく はアルケニル基を表す。

【請求項2】 一般式(1-1)~(1-5)の少なく ともいずれかで表される基を含有する繰り返し単位が、 下記一般式 (AI) 又は (AII) で表される繰り返し 単位であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型感 光性組成物。

[化3]

一般式(AI)中、R.,は、水素原子、ハロゲン原子又 はアルキル基を表す。A'は、単結合又2価の連結基を 表す。 B は、上記一般式 (1-1) ~ (1-5) の少な くともいずれかで表される基を表す。

【化4】

(AII)

一般式(AII)中、A'及びBは、それぞれ一般式 (AI) に於けるA'及びBと同義である。

(A) 成分の化合物が、スルホニウム塩 【請求項3】 であることを特徴とする請求項1又は2に記載のポジ型 10 感光性組成物。

更に、塩基性化合物及び、フッ素系界面 【請求項4】 活性剤又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴 とする請求項1~3のいずれかに記載のポジ型感光性組 成物。

【請求項5】 塩基性化合物が、アルキルアミン構造、 エーテル結合を有するアルキルアミン構造、水酸基を有 するアルキルアミン構造、アニリン構造、ピリジン構 造、ジアザビシクロ構造、アンモニウムヒドロキシド構 造、アンモニウムカルボキシレート構造及びイミダゾー 20 ル構造から選ばれる少なくとも1種の構造を有する化合 物であることを特徴とする請求項4に記載のポジ型感光 性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、IC等の半導体製 造工程、液晶、サーマルヘッド等の回路基板の製造、さ らにその他のフォトファブリケーション工程に使用され るポジ型感光性組成物に関するものである。さらに詳し くは250 nm以下の遠紫外線等を露光光源とする場合 に好適なポジ型感光性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】化学増幅系ポジ型レジスト組成物は、遠 紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、 この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部 と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させ、パター ンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

【0003】 KrFエキシマレーザーを露光光源とする 場合には、主として248nm領域での吸収の小さい、 ポリ (ヒドロキシスチレン) を基本骨格とする樹脂を主 40 成分に使用するため、高感度、高解像度で、且つ良好な パターンを形成し、従来のナフトキノンジアジド/ノボ ラック樹脂系に比べて良好な系となっている。

【0004】しかしながら、更に短波長の光源、例えば ArFエキシマレーザー(193nm)を露光光源とし て使用する場合は、芳香族基を有する化合物が本質的に 193nm領域に大きな吸収を示すため、上記化学増幅 系でも十分ではなかった。また、193nm波長領域に 吸収の小さいポリマーとして、ポリ(メタ)アクリレー トの利用がJ. Vac. Sci. Technol., B 50 9, 3357 (1991) に記載されているが、この

ポリマーは一般に半導体製造工程で行われるドライエッチングに対する耐性が、芳香族基を有する従来のフェノール樹脂に比べ低いという問題があった。

[0005] また、特開2000-122294号公報 には、脂環ラクトン構造を有する繰り返し単位を含有す る樹脂を用いたレジスト組成物が記載されている。しか しながら、従来のレジスト組成物は、解像力の更なる改 良が望まれていたし、レジスト膜に露光した後に後加熱 までに時間が経過すると、解像力が低下する問題もあっ た。更に、疎密依存性の問題においても改善の余地があ 10 った。最近のデバイスの傾向として様々なパターンが含 まれるためレジストには様々な性能が求められており、 その1つに、疎密依存性がある。即ち、デバイスにはラ インが密集する部分と、逆にラインと比較しスペースが 広いパターン、更に孤立ラインが存在する。このため、 種々のラインを高い再現性をもって解像することは重要 である。しかし、種々のラインを再現させることは光学 的な要因により必ずしも容易でなく、レジストによる解 決方法も明確でないのが現状である。特に、前記の脂環 式基を含有するレジスト系においては孤立パターンと密 20 集パターンの性能差が顕著であり、改善が望まれてい た。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、解像力に優れ、レジスト膜に露光した後に後加熱までに時間が経過しても解像力が低下することがなく、且つ疎密依存性に優れたポジ型感光性組成物を提供することにある。

[0.007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、鋭意検討 30 した結果、特定の構造の酸を発生する化合物及び特定の酸分解性樹脂を併用することによって、上記目的を達成し得ることを見出し、下記の本発明(1)~(5)を完成するに至った。

【0008】 (1) (A) 活性光線又は放射線の照射により、少なくとも1つのフッ素原子又は少なくとも1つのフッ素原子を有する基で置換された芳香族スルホン酸を発生する化合物及び(B)下記一般式(1-1)~(1-5)の少なくともいずれかで表される基を含有する繰り返し単位を有し、酸の作用により分解し、アルカ40リ現像液中での溶解度が増大する樹脂を含有することを特徴とするポジ型感光性組成物。

[0009]

【化5】

【0011】一般式 $(1-1) \sim (1-5)$ に於いて、 $R_i \sim R_i$ は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、水酸基、カルボキシル基又は置換基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシカルボニル基若しくはアルケニル基を表す。

【0012】(2) 一般式(1-1)~(1-5)の少なくともいずれかで表される基を含有する繰り返し単位が、下記一般式(AI)又は(AII)で表される繰り返し単位であることを特徴とする(1)に記載のポジ型感光性組成物。

[0013]

【化7】

 $[0\ 0\ 1\ 4]$ 一般式 $(A\ I)$ 中、 R_{11} は、水素原子、ハロゲン原子又はアルキル基を表す。A' は、単結合又 2 価の連結基を表す。B は、上記一般式 $(1-1)\sim(1-5)$ の少なくともいずれかで表される基を表す。

[0015]

(化8)

(AII)

【0016】一般式 (AII) 中、A'及びBは、それ ぞれ一般式 (AI) に於けるA'及びBと同義である。 【0017】 (3) (A) 成分の化合物が、スルホニ

ウム塩であることを特徴とする(1)又は(2)に記載 のポジ型感光性組成物。

【0018】(4) 更に、塩基性化合物及び、フッ素 系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を含有すること を特徴とする(1)~(3)のいずれかに記載のポジ型 感光性組成物。

[0019] (5) 塩基性化合物が、アルキルアミン 構造、エーテル結合を有するアルキルアミン構造、水酸 基を有するアルキルアミン構造、アニリン構造、ピリジ ン構造、ジアザビシクロ構造、アンモニウムヒドロキシ 10 ド構造、アンモニウムカルボキシレート構造及びイミダ ゾール構造から選ばれる少なくとも1種の構造を有する 化合物であることを特徴とする(4)に記載のポジ型感 光性組成物。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する各成分に

ついて詳細に説明する。

≪光酸発生剤≫まず、(A)活性光線又は放射線の照射 により酸を発生する化合物(光酸発生剤)について説明 する。本発明で用いられる光酸発生剤は、活性光線又は 放射線の照射により、少なくとも1つのフッ素原子又は 少なくとも1つのフッ素原子を有する基で置換された芳 香族スルホン酸を発生する化合物であり、フッ素原子及 びフッ素原子を有する基の両方で置換された芳香族スル ホン酸を発生する化合物でもよく、好ましくは下記一般 式 (I) ~ (III) で表される化合物である。芳香族ス ルホン酸としては、例えば、ベンゼンスルホン酸、ナフ タレンスルホン酸、アントラセンスルホン酸等を挙げる ことができる。

[0021]【化9】

$$R_{8}$$
 R_{9}
 R_{10}
 R_{11}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{14}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{13}
 R_{14}

$$R_{16}$$
 R_{17} R_{24} R_{25} R_{25}

[0022] 式中、R,~R,,は、同一又は異なって、 水素原子、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基、直 鎖状、分岐状あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシル 基、ハロゲン原子、又は-S-R,,基を表す。R,,は、 直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基又はアリール基 50 素原子、少なくとも1個のフッ素原子で置換された直鎖

を表す。また、R₁~R₁₆、R₁₆~R₂₇、R₂₈~R₃₇の うち、2つ以上が結合して、単結合、炭素、酸素、イオ ウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環 を形成していてもよい。 X は、少なくとも1個のフッ

状、分岐状あるいは環状アルキル基、少なくとも1個の フッ素原子で置換された直鎖状、分岐状あるいは環状ア ルコキシ基、少なくとも1個のフッ素原子で置換された アシル基、少なくとも1個のフッ素原子で置換されたア シロキシ基、少なくとも1個のフッ素原子を含有するア ルキルまたはアリールスルホニル基、少なくとも1個の フッ素原子を含有するアルキルまたはアリールスルホニ ルオキシ基、少なくとも1個のフッ素原子を含有するア ルキルまたはアリールスルホニルアミノ基、少なくとも 1個のフッ素原子で置換されたアリール基、少なくとも 10 1個のフッ素原子で置換されたアラルキル基、及び少な くとも1個のフッ素原子で置換されたアルコキシカルボ ニル基、から選択された少なくとも1種を有するペンゼ ンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アントラセンス ルホン酸等の芳香族スルホン酸のアニオンを示す。

【0023】一般式 (I) ~ (III) において、R,~R 38の直鎖状、分岐状アルキル基としては、置換基を有し てもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチ ル基、 s e c - プチル基、 t - プチル基のような炭素数 1~4個のものが挙げられる。環状アルキル基として は、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロ ペンチル基、シクロヘキシル基のような炭素数3~8個 のものが挙げられる。R₁~R₃₇の直鎖状、分岐状アル コキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、 ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n-ブトキシ 基、イソプトキシ基、sec-プトキシ基、t-プトキ シ基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。 環状 アルコキシ基としては、シクロペンチルオキシ基、例え ば、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基 が挙げられる。

【0024】R₁~R₃,のハロゲン原子としては、フッ 素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることが できる。R,。のアリール基としては、例えば、フェニル 基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のよう な置換基を有してもよい炭素数6~14個のものが挙げ られる。これらの置換基として好ましくは、炭素数1~ 4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素 原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、炭 素数2~6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ 基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基 40 等が挙げられる。

[0025] また、 $R_1 \sim R_{16}$ 、 $R_{16} \sim R_{17}$ 、 $R_{18} \sim R$ 37のうち、2つ以上が結合して形成する、単結合、炭 素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2 種以上を含む環としては、例えば、フラン環、ジヒドロ フラン環、ピラン環、トリヒドロピラン環、チオフェン 環、ピロール環等を挙げることができる。

【0026】一般式 (I) ~ (III) において、X は下 記基から選択される少なくとも1種を有するペンゼンス ルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アントラセンスルホ 50

ン酸等の芳香族スルホン酸のアニオンである。

少なくとも1個のフッ素原子

少なくとも 1 個のフッ素原子で置換された直鎖状、分岐 状あるいは環状アルキル基

少なくとも1個のフッ素原子で置換された直鎖状、分岐 状あるいは環状アルコキシ基

少なくとも 1 個のフッ素原子で置換されたアシル基 少なくとも1個のフッ素原子で置換されたアシロキシ基 少なくとも 1 個のフッ素原子を含有するアルキルまたは アリールスルホニル基

少なくとも1個のフッ素原子を含有するアルキルまたは アリールスルホニルオキシ基

少なくとも1個のフッ素原子を含有するアルキルまたは アリールスルホニルアミノ基

少なくとも 1 個のフッ素原子で置換されたアリール基 少なくとも1個のフッ素原子で置換されたアラルキル基

少なくとも 1 個のフッ素原子で置換されたアルコキシカ ルボニル基

【0027】上記直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル 基としては、炭素数が $1 \sim 12$ であって、 $1 \sim 25$ 個の フッ素原子で置換されているものが好ましい。具体的に はフロロメチル基、ジフロロメチル基、トリフロロメチ ル基、ペンタフロロエチル基、2,2,2-トリフロロ エチル基、ヘプタフロロプロピル基、ヘプタフロロイソ プロピル基、パーフロロブチル基、パーフロロオクチル 基、パーフロロドデシル基、パーフロロシクロヘキシル 基等を挙げることができる。なかでも、全てフッ素で置 換された炭素数1~4のパーフロロアルキル基が好まし 30 Vi.

【0028】上記直鎖状、分岐状あるいは環状アルコキ シ基としては、炭素数が1~12であって、1~25個 のフッ素原子で置換されているものが好ましい。具体的 にはトリフロロメトキシ基、ペンタフロロエトキシ基、 ヘプタフロロイソプロピルオキシ基、パーフロロブトキ シ基、パーフロロオクチルオキシ基、パーフロロドデシ ルオキシ基、パーフロロシクロヘキシルオキシ基等を挙 げることができる。なかでも、全てフッ素で置換された 炭素数1~4のパーフロロアルコキシ基が好ましい。

[0029] 上記アシル基としては、炭素数が2~12 であって、1~23個のフッ素原子で置換されているも のが好ましい。具体的にはトリフロロアセチル基、フロ ロアセチル基、ペンタフロロプロピオニル基、ペンタフ ロロベンソイル基等を挙げることができる。

【0030】上記アシロキシ基としては、炭素数が2~ 12であって、1~23個のフッ素原子で置換されてい るものが好ましい。具体的にはトリフロロアセトキシ 基、フロロアセトキシ基、ペンタフロロプロピオニルオ キシ基、ペンタフロロベンゾイルオキシ基等を挙げるこ とができる。

【0031】上記アルキルまたはアリールスルホニル基としては、炭素数が1~12であって、1~25個のフッ素原子を含有するものが好ましい。具体的にはトリフロロメタンスルホニル基、ペンタフロロエタンスルホニル基、パーフロロブタンスルホニル基、パーフロロオクタンスルホニル基、ペンタフロロベンゼンスルホニル基、4-トリフロロメチルベンゼンスルホニル基等を挙げることができる。

【0032】上記アルキルまたはアリールスルホニルオ 基、ペンタフロロフェノギシカルホニル基、パーフロロオクチルオキシカル ボニル基等を挙げることができる。 【0037】最も好ましいX としてはフッ素原子で置 換されたベンゼンスルホン酸アニオンであり、ルホニルオキシ基等を挙げることができる。 ル基で置換されたベンゼンスルホン酸アニオンであり、

【0033】上記アルキルまたはアリールスルホニルアミノ基としては、炭素数が1~12であって、1~25個のフッ素原子を含有するものが好ましい。具体的にはトリフロロメタンスルホニルアミノ基、パーフロロブタンスルホニルアミノ基、ペンタフロロベンゼンスルホニルアミノ基等20を挙げることができる。

【0034】上記アリール基としては、炭素数が6~14であって、1~9個のフッ素原子で置換されているものが好ましい。具体的にはペンタフロロフェニル基、4ートリフロロメチルフェニル基、ヘプタフロロナフチル基、ノナフロロアントラニル基、4ーフロロフェニル基、2,4ージフロロフェニル基等を挙げることができる。

【0035】上記アラルキル基としては、炭素数が7~ 10であって、1~15個のフッ素原子で置換されてい 30

るものが好ましい。具体的にはペンタフロロフェニルメチル基、ペンタフロロフェニルエチル基、パーフロロベンジル基、パーフロロフェネチル基等を挙げることができる。

【0036】上記アルコキシカルボニル基としては、炭素数が2~13であって、1~25個のフッ素原子で置換されているものが好ましい。具体的にはトリフロロメトキシカルボニル基、ペンタフロロフェノキシカルボニル基、パーフロロブトキシカルボニル基、パーフロロオクチルオキシカルボニル基等を挙げることができる。

【0037】最も好ましいX⁻としてはフッ素原子で置換されたベンゼンスルホン酸アニオン、トリフロロメチル基で置換されたベンゼンスルホン酸アニオンであり、中でもペンタフロロベンゼンスルホン酸アニオン、2-または3-または4-トリフロロメチルベンゼンスルホン酸アニオン、3,5-ビストリフロロメチルベンゼンスルホン酸アニオンが特に好ましい。

【0038】また、上記含フッ素置換基を有する芳香族スルホン酸は、さらに直鎖状、分岐状あるいは環状アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、スルホニル基、スルホニルオキシ基、スルホニルアミノ基、アリール基、アラルキル基、アルコキシカルボニル基(これらの炭素数範囲は前記のものと同様)、ハロゲン(フッ素を除く)、水酸基、ニトロ基等で置換されてもよい。

【0039】一般式 (I) で表される成分 (A) の好ま しい具体例を以下に示す。

[0040]

【化10】

[0041]

【化11】

[0042] [化12]

[0043] [化13]

(10)

[0044]

[0045] 一般式 (II) で表される成分 (A) の好ま しい具体例を以下に示す。

[0046] 【化15】

[0047] 一般式 (111) で表される成分 (A) の好 40 [0048] ましい具体例を以下に示す。 【化16】

 $[0\ 0\ 4\ 9]$ また、一般式 $(I\ V)\sim (V\ I\ I)$ で表される化合物も本発明の成分 (A) として好ましい。

[0050]

【化17】

$$\begin{array}{cccc} CH_2OSO_2Rc & O \\ NO_2 & A \\ (VI) & O \\ (VII) & O \end{array}$$

[0051] 式中、Ra, Rbは、同一でも異なっていてもよく、置換していてもよい直鎖、分岐、または環状 アルキル基、置換していてもよいアリール基、置換して

いてもよいヘテロアリール基、置換していてもよいアラルキル基を示す。ただしRa, Rbのうちの少なくとも一方は少なくとも1つのフッ素原子又は少なくとも1つのフッ素原子を有する基で置換されたフェニル基、ナフタレン基、またはアントラセン基を示す。

【0052】Rcは、少なくとも1つのフッ素原子又は 少なくとも1つのフッ素原子を有する基で置換されたフェニル基、ナフタレン基、またはアントラセン基を示 す。Rdは、置換していてもよい直鎖、分岐、環状アル キル基、置換していてもよいアリール基、置換していて 10 もよいヘテロアリール基、置換していてもよいアラルキル基を示す。 R は、水素原子、置換していてもよい直鎖、分岐、環状アルキル基、ニトロ基、アルコキシ基を示す。 A は置換または無置換のアルキレン基、アリーレン基、またはアルケニレン基を表す。 一般式 (IV) ~ (VII) で表される成分 (A) の好ましい具体例を以下に示す。

[0053]

【化18】

40 【化19】

[0054]

【0056】一般式(I)~(VII)で表される成分 (A) は、1種あるいは2種以上を併用して用いてもよ い。成分(A)の含量は、本発明のポジ型感光性組成物 の固形分に対し、通常0.1~20重量%、好ましくは 0. 5~10重量%、更に好ましくは1~7重量%であ る。

【0057】一般式 (I)、 (II) の化合物は、例えば アリールマグネシウムプロミド等のアリールグリニャー ル試薬と、置換又は無置換のフェニルスルホキシドとを 50

反応させ、得られたトリアリールスルホニウムハライド を対応するスルホン酸と塩交換する方法、置換あるいは 無置換のフェニルスルホキシドと対応する芳香族化合物 とをメタンスルホン酸/五酸化二リンあるいは塩化アル ミニウム等の酸触媒を用いて縮合、塩交換する方法、又 はジアリールヨードニウム塩とジアリールスルフィドを 酢酸銅等の触媒を用いて縮合、塩交換する方法等によっ て合成することができる。式 (111) の化合物は過ヨウ 素酸塩を用いて芳香族化合物を反応させることにより合 ì.

成することができる。また、塩交換に用いるスルホン酸 あるいはスルホン酸塩は、市販のスルホン酸クロリドを 加水分解する方法、芳香族化合物とクロロスルホン酸と を反応する方法、芳香族化合物とスルファミン酸とを反 応する方法等によって得ることができる。

【0058】(A)成分以外の併用しうる酸発生化合物 本発明においては、成分(A)以外に、活性光線又は放 射線の照射により分解して酸を発生する化合物を更に併 用してもよい。本発明の(A)成分と併用しうる光酸発 生剤の使用量は、モル比(成分(A)/その他の酸発生 剤) で、通常100/0~20/80、好ましくは10 0/0~40/60、更に好ましくは100/0~50 /50である。特に芳香環構造を有する光酸発生剤を併 用する場合、その使用量は、重量比で全酸発生剤の60 %以下が好ましく、更に好ましくは50%以下である。 そのような併用可能な光酸発生剤としては、光カチオン 重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の 光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使 用されている活性光線又は放射線の照射により酸を発生 する公知の化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して 20 により分解して酸を発生する化合物の中で、特に好まし 使用することができる。

【0059】たとえば、ジアゾニウム塩、ホスホニウム 塩、スルホニウム塩、ヨードニウム塩、イミドスルホネ

$$(z1)$$
S⁺ CF₃SO₃⁻

$$(-)_3 S^+ C_4 F_9 SO_3$$
(z3)

[0064] 【化22】

ート、オキシムスルホネート、ジアゾジスルホン、ジス ルホン、o-ニトロペンジルスルホネートを挙げること ができる。特に好ましくは、スルホニウム塩であり、ト リアリールスルホニウム塩、フェナシルスルホニウム 塩、2-オキソアルキル基を有するスルホニウム塩が最 も好ましい。

[0060] また、これらの活性光線又は放射線の照射 により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主 鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、米国特許第 3,849,137号、独国特許第3914407号、 特開昭63-26653号、特開昭55-164824 号、特開昭62-69263号、特開昭63-1460 38号、特開昭63-163452号、特開昭62-1 53853号、特開昭63-146029号等に記載の 化合物を用いることができる。

【0061】さらに米国特許第3,779,778号、欧 州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生 する化合物も使用することができる。

[0062]併用してもよい活性光線又は放射線の照射 いものの例を以下に挙げる。

[0063]

【化21】

$$S^{+} C_{4}F_{9}SO_{3}^{-}$$
(z2)

[0065] 【化23】

【化24】

[0066]

[0069]

30 【化27】

31

CF₃SO₃

$$CF_3SO_3$$
 CF_3SO_3
 CF_3SO_3
 CF_3
 CF_3

[0070]

【化28】

【0072】≪(B)酸の作用によりアルカリ現像液に 対する溶解度が増加する樹脂(「酸分解性樹脂」ともい う) ≫

【0073】本発明の(B)酸分解性樹脂としては、前 記一般式(1-1)~(1-5)の少なくともいずれか で表される基を含有する繰り返し単位を有し、酸の作用 により分解し、アルカリ現像液に対する溶解度が増加す る樹脂が使用される。

【0074】一般式(1-1)~(1-5)に於いて、 $R_1 \sim R_s$ は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、 水酸基、カルボキシル基又は置換基を有していてもよ い、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシカルボ ニル基若しくはアルケニル基を表す。

【0075】一般式(1-1)~(1-5)において、

R₁~R₆におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐状 のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。 直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数1~12 個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より 好ましくは炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状ア ルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、 プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチ ル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、 ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシ ル基である。R₁~R₄におけるシクロアルキル基として は、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキ シル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素 数3~8個のものが好ましい。R1~R5のアルコキシカ 50 ルボニル基におけるアルキル基としては、上記のアルキ ル基、シクロアルキル基を挙げることができる。 R₁ ~ R₅ におけるアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基等の炭素数 2 ~ 6 個のものが好ましい。

【0076】また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルケニル基の更なる置換基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0077】一般式(1-1)~(1-5)で表される基を有する繰り返し単位として好ましいものとして、前記一般式(AI)で表される繰り返し単位が挙げられる。

【0078】一般式 (AI) 中、R.,は、水素原子、ハ

ロゲン原子又はアルキル基を表す。A は、単結合又は 2 価の連結基を表す。B は、一般式 $(1-1) \sim (1-5)$ の少なくともいずれかで表される基を表す。

【0079】 $R_{\bullet \bullet}$ のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子等を挙げることができる。 $R_{\bullet \bullet}$ のアルキル基としては、一般式(1-1)~(1-5) に於けるアルキル基と同様のものを挙げることができる。

【0080】A'の2価の連結基としては、例えば、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、若しくはこれらを組み合わせた2価の連結基を挙げることができる。A'において、該組み合わせた2価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

[0081] [化30]

【0082】上記式において、Ra、Rbは、同じでも 40 異なっていてもよく、水素原子、水酸基、アルキル基、 置換アルキル基又はアルコキシ基を表す。 r 1は、1~ 10の整数を表す。 mは1~3の整数を表す。

【0083】Ra、Rbのアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、プロポキシ 50

) 基、プトキシ基等の炭素数 1 ~ 4 個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0084】一般式(AI)に於いて、A'は、一般式 (1-1) \sim (1-5) で表される基を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

[0085]以下に、一般式(AI)で表される繰り返 し単位の具体例を挙げるが、本発明の内容がこれらに限 定されるものではない。

[0086]

【化31】

[0087]

【化32】

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
-(CH_2-C) \\
O \\
H_3C
\end{array}$$
(1-14)

[0088]

[化33]

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_4 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_4 \\ \\ \text{CH}_2 - \text{C} \\ \\ \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_5 \\ \\ \text{CH}_5$$

[0090]

[0089]

【化35】

(1-29)

(1-30)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} - \text{C} \\ \text{C} \\$$

(1-40)

[0091]

【化36】

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{2}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{2}-CH_{3}$$

$$C-O$$

$$-CH_2 - C - O$$

$$C - O$$

$$-CH_{2}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{CH_{3}}{\overset{|}{C}}-\overset{C$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{2}-CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{3}$$

[0092]

[化37]

$$-CH_2 - CH_3 - CONHSO_2CH_3$$

$$-CH_2 - CH_3 - CONHSO_2CH_3$$

[0093] 前記一般式(1-1)~(1-5)のいず 20 - れかで表される基を含有する繰り返し単位としては、前記一般式(AII)で表される繰り返し単位も好ましい。

 $[0\ 0\ 9\ 4]$ 一般式 $(A\ I\ I)$ に於けるA $^{\prime}$ 及びBは、それぞれ一般式 $(A\ I)$ に於けるA $^{\prime}$ 及びBと同義である。

【0095】以下に、一般式(AII)で表される繰り返し単位の好ましい具体例を挙げるが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0096] [化38]

[0097] [化39]

[0098]

30

【0099】本発明に於ける(B)成分の酸分解性樹脂は、下記一般式(pI)~一般式(pVI)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位及び下記一般式(II)で示される繰り返し単位の群から選択される少なくとも1種を含有することが好ましい。

[0100]

【化41】

$$-\overset{O}{C}-\overset{\mathsf{R}_{11}}{\overset{\circ}{C}}$$

【0101】(式中、Rilは、メチル基、エチル基、n プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソブ チル基又はsecープチル基を表し、Zは、炭素原子と ともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を 表す。R11~R16は、各々独立に、炭素数1~4個の、 直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を 表し、但し、R.1~R.4のうち少なくとも1つ、もしく はRis、Risのいずれかは脂環式炭化水素基を表す。R 1,~R,1は、各々独立に、水素原子、炭素数1~4個 の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素 基を表し、但し、R₁,~R₂,のうち少なくとも1つは脂 環式炭化水素基を表す。また、R.,、R.,のいずれかは 炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は 脂環式炭化水素基を表す。 R., ~ R., は、各々独立に、 炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は 脂環式炭化水素基を表し、但し、R,,~R,,のうち少な くとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、R13とR ,,は、互いに結合して環を形成していてもよい。)

[0102]

【化42】

【0 1 0 3】式 (II) 中: R,,', R,,'は、各々独立 に、水素原子、シアノ基、ハロゲン原子、又は置換基を 有していてもよいアルキル基を表す。 Z'は、結合した 2つの炭素原子 (C-C) を含み、置換基を有していて 30 sec-ブチル基、t-プチル基等が挙げられる。ま もよい脂環式構造を形成するための原子団を表す。

【0104】また、上記一般式(11)は、下記一般式 (II-A) 又は一般式 (II-B) であることが更に好ま しい。

[0105]

【化43】

$$R_{13}$$
 R_{14}
 R_{16}
 R_{15}
 R_{16}
 R_{15}
 R_{16}
 R_{17}
 R_{18}
 R_{18}
 R_{18}

[0106]式(II-A)、(II-B)中:R₁₃'~R 16'は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、-COOH、-COOR。、酸の作用により分解す

る基、-C (=O) -X-A'-R₁₁'、又は置換基を有 していてもよいアルキル基あるいは環状炭化水素基を表 す。ここで、R。は、置換基を有していてもよい、アル キル基、環状炭化水素基又は下記の-Y基を表す。X は、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NHSO:-又 は-NHSO,NH-を表す。A'は単結合又は2価の連 結基を表す。また、R₁₃'~R₁₆'のうち少なくとも2つ が結合して環を形成してもよい。 nは0又は1を表す。 R,,'は、-COOH、-COOR,、-CN、水酸基、 10 置換基を有していてもよいアルコキシ基、-CO-NH -R₄、-CO-NH-SO₄-R₄又は下記の-Y基を 表す。R₆は、置換基を有していてもよい、アルキル基 又は環状炭化水素基を表す。- Y基;

[0107]

【化44】

20

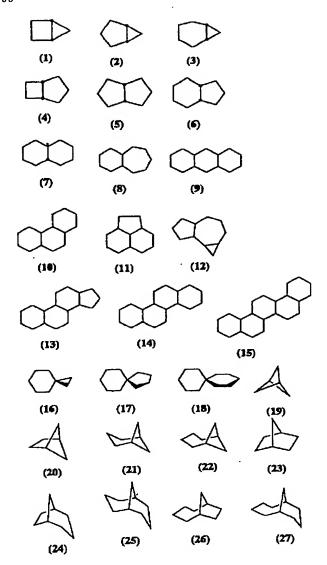
【0108】 (-Y基中、R₁₁'~R₁₀'は、各々独立 に、水素原子又は置換基を有していてもよいアルキル基 を表す。 a, bは1又は2を表す。)

[0109] 一般式 (pI) ~ (pVI) において、R 、、~R、におけるアルキル基としては、置換もしくは非 置換のいずれであってもよい、1~4個の炭素原子を有 する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキ ル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピ ル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、 た、上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1 ~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩 素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキ シ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカ ルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

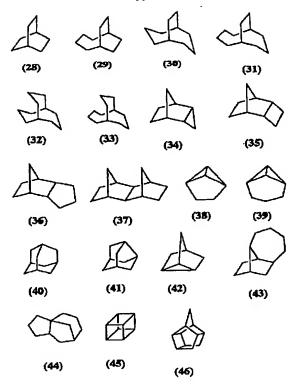
【0110】R₁₁~R₁,における脂環式炭化水素基ある いは2と炭素原子が形成する脂環式炭化水素基として は、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数 5以上のモノシクロ、ピシクロ、トリシクロ、テトラシ 40 クロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素 数は6~30個が好ましく、特に炭素数7~25個が好 ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有してい てもよい。以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部 分の構造例(以下、脂環式部分構造例Aともいう)を示 す。

[0111]

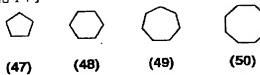
【化45】



[0112] [化46]



[0113]



【0114】本発明においては、上記脂環式部分の好ま 30 しいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペデカニル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基である。

【0115】これらの脂環式炭化水素基の置換基として 40 は、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸 基、アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基よりなる群から選択された置換基を表す。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等の炭素数1~4個 50

のものを挙げることができる。

[0116]上記樹脂における一般式(pI)~(pVI)で示される構造は、アルカリ可溶性基の保護に使用することができる。アルカリ可溶性基としては、この技術分野において公知の種々の基が挙げられる。具体的には、カルボン酸基、スルホン酸基、フェノール基、チオール基などが挙げられ、好ましくはカルボン酸基、スルホン酸基である。上記樹脂における一般式(pI)~(pVI)で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基としては、好ましくは下記一般式(pVII)~(pXI)で表される基が挙げられる。

[0117] [化48]

$$\begin{array}{c|c}
 & R_{19} \\
 & R_{19} \\
 & R_{20}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & R_{18} \\
 & R_{20}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & \cdots \\
 & R_{20}
\end{array}$$

【0118】 ここで、 $R_{II} \sim R_{II}$ ならびにZは、それぞれ前記定義に同じである。上記樹脂において、一般式 (pI) \sim (pVI) で示される構造で保護されたアルカリ可溶性基を有する繰り返し単位としては、下記一般式 (pA) で示される繰り返し単位が好ましい。【0119】

f // 4 0 7

【化49】

$$\begin{array}{c}
 & 57 \\
 & \downarrow \\$$

【0120】ここで、Rは、水素原子、ハロゲン原子又 は1~4個の炭素原子を有する置換もしくは非置換の直 鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。複数のRは、各々 同じでも異なっていてもよい。Aは、単結合、アルキレ 10

ン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル 基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォン アミド基、ウレタン基、又はウレア基よりなる群から選 択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表 す。Raは、上記式(pI)~(pVI)のいずれかの 基を表す。

【0121】以下、一般式(pA)で示される繰り返し 単位に相当するモノマーの具体例を示す。

[0122]

[化50]

$$= \begin{array}{c} CH_3 & CH_3 \\ O & \end{array}$$

$$\qquad \qquad \bigcup_{\substack{\text{CH}_3\\\text{CH}_3}} \text{O} - \bigcup_{\substack{\text{CH}_3\\\text{CH}_3}} \text{CH}_3$$

$$= \underbrace{\begin{array}{c} H \\ O - \stackrel{!}{C} \\ \stackrel{!}{C} \\ \\ \stackrel{!}{C} \\ \end{array}}_{CH_3}$$

[0123]

15

(化52)

16

[0124]

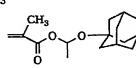
$$= \begin{matrix} \begin{matrix} H \\ O \end{matrix} \begin{matrix} CH_3 \\ CH_3 \end{matrix} \begin{matrix} CH_3 \end{matrix}$$

[0125]

31 H₃C CH₃

【化53】

$$= \bigcup_{H_3C} CH_3$$



34

35

36

[0126]

【化54】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \\ O \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \end{array}$$

【0127】上記一般式 (II) において、R_{II}'、R_I は、各々独立に、水素原子、シアノ基、ハロゲン原子、 又は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。 Z' は、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基 を有していてもよい脂環式構造を形成するための原子団 を表す。

【0128】上記R、、、、、、、、におけるハロゲン原子と しては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等 30 を挙げることができる。上記 R:1'、 R:1'、 R:1'~ R 30'におけるアルキル基としては、炭素数1~10個の 直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ま しくは炭素数1~6個の直鎖状あるいは分岐状アルキル 基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピ ル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、 sec-ブチル基、t-ブチル基である。

【0129】上記のアルキル基における更なる置換基と しては、水酸基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アル コキシ基、アシル基、シアノ基、アシルオキシ基等を挙 40 げることができる。ハロゲン原子としては塩素原子、臭 素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができ、 アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポ キシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げる ことができ、アシル基としてはホルミル基、アセチル基 等を挙げることができ、アシルオキシ基としてはアセト キシ基等を挙げることができる。

【0130】上記2'の脂環式構造を形成するための原 子団は、置換基を有していてもよい脂環式炭化水素の繰 式の脂環式炭化水素の繰り返し単位を形成する有橋式脂 環式構造を形成するための原子団が好ましい。形成され る脂環式炭化水素の骨格としては、前記脂環式部分構造 例Aと同様のものを挙げることができる。

【0131】好ましい有橋式の脂環式炭化水素の骨格と しては、前記脂環式部分構造Aのうち、(5)、

(6), (7), (9), (10), (13), (14), (15), (23), (28), (36), (3 7)、(42)、(47)が挙げられる。

【0132】上記脂環式炭化水素の骨格には置換基を有 していてもよい。そのような置換基としては、上記一般 式(11-A) あるいは(11-B) 中のR,,'~R,,'を挙 げることができる。上記有橋式の脂環式炭化水素を有す る繰り返し単位の中でも、上記一般式(II-A)あるい は(II-B)で表される繰り返し単位が更に好ましい。 【0133】上記一般式 (II-A) あるいは (II-B) において、R1, '~R1, 'は、各々独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、シアノ基、-COOH、-COOR。、酸 の作用により分解する基、-C (=O) -X-A'-R い'、又は置換基を有していてもよいアルキル基あるい は環状炭化水素基を表す。 R, は、置換基を有していて もよい、アルキル基、環状炭化水素基又は前記の-Y基 を表す。Xは、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NH SO,-又は-NHSO,NH-を表す。A'は、単結合 または2価の連結基を表す。また、R1, '~R16'のうち 少なくとも2つが結合して環を形成してもよい。nは0 又は1を表す。R₁,'は、-COOH、-COOR。、 り返し単位を樹脂に形成する原子団であり、中でも有橋 50 - CN、水酸基、置換基を有していてもよいアルコキシ 基、 $-CO-NH-R_6$ 、 $-CO-NH-SO_1-R_6$ 又は下記の-Y基を表す。 R_6 は、置換基を有していてもよい、アルキル基又は環状炭化水素基を表す。前記-Y基において、 R_{11} $^{'}\sim R_{30}$ $^{'}$ は、各々独立に、水素原子又は置換基を有していてもよいアルキル基を表し、a、bは1又は2を表す。

63

【0134】本発明に係わる樹脂において、酸分解性基は、上記-C (=O) -X-A'-R₁,'に含まれてもよいし、一般式 (II) の2'の置換基として含まれてもよい。酸分解性基の構造としては、-C (=O) - X_1 - 10 R₀。で表される。式中、R₀。としては、t-ブチル基、t-アミル基等の3級アルキル基、イソボロニル基、1-エトキシエチル基、1-ブトキシエチル基、1-イソブトキシエチル基、1-ジクロヘキシロキシエチル基、1-メトキシメチル基、1-メトキシメチル基、1-エトキシメチル基等のアルコキシメチル基、3-オキソアルキル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル基、トリアルキルシリルエステル基、3-オキソシクロヘキシルエステル基、2-メチル-2-アダマンチル基、メバロニックラクトン残基等を挙げる 20 ことができる。 X_1 は、上記Xと同義である。

【0135】上記 R_{13} 、 $\sim R_{13}$ 、におけるハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0137】上記R、、R、、R、、R、、'~R、'、'~R、'における環状 炭化水素基としては、例えば環状アルキル基、有橋式炭 化水素であり、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、アダマンチル基、2ーメチルー2ー アダマンチル基、ノルボルニル基、ボロニル基、イソボロニル基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンテニル基、ノボルナンエポキシ基、メンチル基、イソメンチル基、ネオメンチル基、テトラシクロドデカニル基等を挙 げることができる。上記R、、'~R、 'のうち少なくとも 40 2つが結合して形成する環としては、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプタン、シクロオクタン等の 炭素数5~12の環が挙げられる。

【0138】上記R₁, におけるアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。

[0139]上記アルキル基、環状炭化水素基、アルコキシ基における更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシ基、アシル基、シ

アノ基、アシルオキシ基、アルキル基、環状炭化水素基等を挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものが挙げることができ、アシル基としてはホルミル基、アセチル基等を挙げることができ、アシルオキシ基としてはアセトキシ基等を挙げることができる。また、アルキル基、環状炭化水素基は、上記で挙げたものが挙10 げられる。

【0140】上記A'の2価の連結基としては、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、ウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせが挙げられる。上記A'におけるアルキレン基、置換アルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。- [$C(R_*)(R_*)$], -

式中、R。、R。は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1~10の整数を表す。

【0141】本発明に係る樹脂においては、酸の作用により分解する基は、前記一般式(pI) ~一般式(pVI) で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位、一般式(II) で表される繰り返し単位、及び後記共重合成分の繰り返し単位のうち少なくとも1種の繰り返し単位に含有することができる。

【0142】上記一般式 (II-A) あるいは一般式 (II-B) における R_{13} $\sim R_{14}$ の各種置換基は、上記一般式 (II) における脂環式構造を形成するための原子団ないし有橋式脂環式構造を形成するための原子団Z の置換基ともなるものである。

[0143] 上記一般式 (II-A) あるいは一般式 (II-B) で表される繰り返し単位の具体例として次の [II-1] ~ [II-175] が挙げられるが、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。

[0144]

【化55】

[0147]

【化58】

[0148]

【化59】

CH₂COOH

[0149]

CH₂CH₂OCH₂CH₃

[0150] [任61]

[11-118]

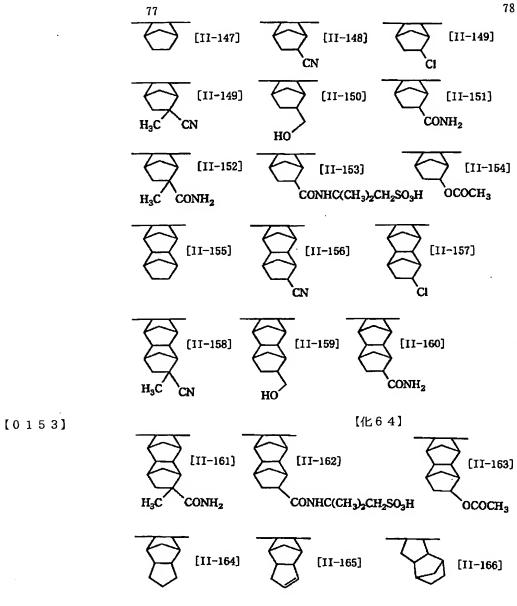
[II-121]

3

[化63]

【化62】

[0152]



[0154]

【化65】

[0156] 本発明の(B) 成分の酸分解性樹脂は、ラクトン構造を有する繰り返し単位を含有することが好ま 40 しい。例えば、下記一般式(IV)で表される繰り返し単位を含有することが好ましい。

[0157] [化67]

Lc:
$$(Rb_1)$$
 (Ra_1) (Re_1)

【0158】一般式(IV)中、R₁aは、水素原子又は メチル基を表す。W₁は、単結合、アルキレン基、エー テル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よ 30 りなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組 み合わせを表す。Ra₁,Rb₁,Rc₁,Rd₁,Re₁ は各々独立に、水素原子又は炭素数1~4のアルキル基 を表す。m,nは各々独立に0~3の整数を表し、m+ nは、2以上6以下である。

【0159】 $Ra_1 \sim Re_1$ の炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、sec-プチル基、t-プチル基等を挙げることができる。

【0160】一般式(IV)において、W₁のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

 $- (C (R f)(R g)) r_{i} -$

上記式中、Rf、Rgは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基として

50 は、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げること

ができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim4$ のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 r_1 は $1\sim1$ 0 の整数である。

【0161】上記アルキル基における更なる置換基としては、カルボキシル基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換アルキル基の置換基として

は、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。置換アルコキシ基の置換基としては、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

ルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、ア 【0162】以下、一般式 (IV) で示される繰り返し ルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。ここで 10 構造単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これら アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル に限定されるものではない。

[0163]

【化69】

[0165] 上記一般式 (IV) の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から、 (IV-17) ~ (IV-24) が好ましい。更に一般式 (IV) の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点からアクリレート構造を有するものが好ましい。

【0166】(B)成分の酸分解性樹脂は、下記一般式 40 (VII)で表される基を有する繰り返し単位を含有してもよい。

[0167] [化70]

$$R_{2c}$$
 R_{4c} (VII)

【0168】一般式(VII)中、 $R_1c\sim R_4c$ は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、 $R_1c\sim R_4c$ のうち少なくとも1つは水酸基を表す。

【0169】一般式(VII)で表される基は、好ましくはジヒドロキシ体、モノヒドロキシ体であり、より好ましくはジヒドロキシ体である。

【0170】一般式(VII)で表される基を有する繰り返し単位としては、上記一般式(II-A)又は(II-B)中の R_1 , $'\sim R_1$, 'のうち少なくとも1つが上記一般式(VII)で表される基を有するもの(例えば-COOR, OR, が一般式(V-1)~(V-4)で表される基を表す)、又は下記一般式(AII)で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

【0171】 【化71】 [0172] 一般式 (AII) 中、 R_1 cは、水素原子又は メチル基を表す。 R_1 c~ R_4 cは、各々独立に水素原子又 は水酸基を表す。ただし、 R_1 c~ R_4 cのうち少なくとも 1つは水酸基を表す。

【0173】以下に、一般式(All)で表される構造を 有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定 されるものではない。

[0174]

[化72]

$$-CH_{2}-CH- OH OH$$

$$-CH2-CH- CH- CH- OH$$

$$C-O \longrightarrow OH$$

$$(2)$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$-CH_{2}-CH_{3}$$

$$C-O-HOH$$

$$O$$

$$(4)$$

[0175] (B) 成分の酸分解性樹脂は、下記一般式 (VIII) で表される基を有する繰り返し単位を含有してもよい。

[0176]

[化73]

[0177] 一般式 (VIII) 中: Z,は、-O-又は-N(R,1) -を表す。ここでR,1は、水素原子、水酸基、アルキル基、ハロアルキル基、又は-OSO,-R,2を表す。R,1は、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基又は樟脳残基を表す。

【0178】上記R、、及びR、、におけるアルキル基としては、炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、secーブチル基、tープチル基である。上記R、、及びR、、におけるハロアルキル基としてはトリフルオロメチル基、ナノフルオロブチル基、ペンタデカフルオロオクチル基、トリクロロメチル基等を挙げることができる。上記R、におけるシクロアルキル基としては、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロオクチル基等を挙げることができる。

【0179】R、及びR、としてのアルキル基及びハロアルキル基、R、としてのシクロアルキル基又は樟脳残基は置換基を有していてもよい。このような置換基としては、例えば、水酸基、カルボキシル基、シアノ基、ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子、フッソ素原子、沃素原子)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等)、アシル基(好ましくは炭素数2~5、例えば、ホルミル基、アセチル基等)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~5、例えばアセトキシ基)、アリール基(好ましくは炭素数6~14、例えばフェニル基)等を挙げることができる。

【0180】上記一般式 (VIII) で表される繰り返し単位の具体例として次の $[I'-1] \sim [I'-7]$ が挙げられるが、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。

[0181] [化74]

[0182] [化75]

$$\begin{array}{c}
-(CH-CH)\\
0 = C\\
0 - SO_2
\end{array}$$
[1'-7]

【0183】(B)成分である酸分解性樹脂は、上記の繰り返し構造単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し構造単位を含有することができる。

【0184】このような繰り返し構造単位としては、下記の単量体に相当する繰り返し構造単位を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。これにより、酸分解性樹脂に要求される性能、特に、(1)塗布 50

溶剤に対する溶解性、(2) 製膜性(ガラス転移点)、(3) アルカリ現像性、(4) 膜べり(親疎水性、アルカリ可溶性基選択)、(5) 未露光部の基板への密着性、(6) ドライエッチング耐性、等の微調整が可能となる。このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

【0185】その他にも、上記種々の繰り返し構造単位 に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の不飽 和化合物であれば、共重合されていてもよい。

【0186】酸分解性樹脂において、各繰り返し構造単位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

【0187】(B)成分の酸分解性樹脂に於いて、一般式(1-1)~(1-5)の少なくともいずれかで表さ20 れる基を含有する繰り返し単位の含有量は、全繰り返し単位中、通常1~90モル%とすればよく、10~70モル%とすることが好ましく、20~60モル%とすることが更に好ましい。

【0188】酸分解性樹脂中、一般式(pI)~(pVI)で表される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中30~70モル%が好ましく、より好ましくは35~65モル%、更に好ましくは40~60モル%である。酸分解性樹脂中、一般式(II)で表される繰り返し単位の含有量30は、全繰り返し構造単位中10~60モル%が好ましく、より好ましくは15~55モル%、更に好ましくは20~50モル%である。

【0189】本発明に用いる酸分解性樹脂は、常法に従 って(例えばラジカル重合)合成することができる。例 えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括で あるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応 じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1,4-ジオ キサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメ チルエチルケトン、メチルイソプチルケトンのようなケ トン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後 述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー トのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均 一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で 必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤(アゾ系開始 剤、パーオキサイドなど)を用いて重合を開始させる。 所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応 終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固形回収等の方法 で所望のポリマーを回収する。反応の濃度は20重量% 以上であり、好ましくは30重量%以上、さらに好まし くは40重量%以上である。反応温度は10℃~150

 \mathbb{C} であり、好ましくは30 \mathbb{C} ~120 \mathbb{C} 、さらに好まし くは50~100℃である。

【0190】本発明に用いる樹脂の重量平均分子量は、 GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは 1,000~200,000である。重量平均分子量が 1,000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣 化が見られるため余り好ましくなく、200,000を 越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるた め製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じ

【0191】本発明のポジ型感光性組成物において、本 発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全 レジスト固形分中40~99.99重量%が好ましく、 より好ましくは50~99.97重量%である。

【0192】≪(C)塩基性化合物≫本発明のポジ型感 光性組成物は、露光から加熱までの経時による性能変化 を低減するために、(C) 塩基性化合物を含有すること が好ましい。好ましい構造として、下記式(A)~

(E) で示される構造を挙げることができる。尚、式 てもよい。

[0193] 【化76】

$$R^{251}$$
 $R^{250} - N - R^{252}$... (A)

【0194】ここでR¹⁵⁰、R¹⁵¹及びR¹⁵¹は、各々独 立に、水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数 1~20アミノアルキル基、炭素数1~20のヒドロキ シアルキル基又は炭素数6~20の置換もしくは非置換 30 のアリール基であり、ここでR**0とR**1は互いに結合 して環を形成してもよい。

[0195]【化77】

$$-N-C=N- \qquad \cdots (B)$$

$$= C - N - \cdots (D)$$

$$R^{254} - C - N - C - R^{255}$$

$$R^{253} - C - N - C - R^{256} - \cdots (E)$$

【0196】(式中、R¹⁶³、R¹⁶⁴、R¹⁶⁶及びR ***は、各々独立に、炭素数1~6のアルキル基を示 す)。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換の グアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置 換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もし 50 くは未置換のアミノアルキルモルフォリン、置換もしく

くは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換の インダーゾル、置換もしくは未置換のピラゾール、置換 もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリ ミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未 置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のピラゾリ ン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未 置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミ ノアルキルモルフォリン等が挙げられ、モノ、ジ、トリ アルキルアミン、置換もしくは未置換のアニリン、置換 10 もしくは未置換のピペリジン、モノあるいはジエタノー ルアミン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ 基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリ ール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ 基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオ キシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0197】好ましい化合物としては、グアニジン、 1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3, -テト ラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノ ピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピ (B)~(E)で示される構造は、環構造の一部であっ 20 リジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルア ミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-ア ミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピ リジン、2-アミノー5-メチルピリジン、2-アミノ -6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4 -アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペ ラジン、N-(2-アミノエチル) ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペリジン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノ ピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノ エチル) ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メ チルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-ト リルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5 ーメチルピラジン、ピリミジン、2、4ージアミノピリ ミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾ リン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル) モルフォリン、1,5-ジアザビ シクロ(4.3.0) ノナー5ーエン、1,8ージアザ ピシクロ〔5. 4. 0〕ウンデカー7-エン、2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール、トリ (n-ブチル) ア 40 ミン、トリ (n-オクチル) アミン、N-フェニルジエ タノールアミン、N-ヒドロキシエチルピペリジン、 2, 6-ジイソプロピルアニリン、N-シクロヘキシル -N'-モルホリノエチルチオ尿素等が挙げられるが、 これに限定されるものではない。

> 【0198】更に好ましい化合物として、置換もしくは 未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピロ リジン、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしく は未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジ ン、置換もしくは未置換のアミノモルホリン、置換もし

, ·

は未置換のピペリジンを挙げることができる。更に、イ ミダゾール構造、ジアザビシクロ構造、オニウムヒドロ キシド構造、オニウムカルボキシレート構造、トリアル キルアミン構造を有する化合物を挙げることができる。 【0199】イミダゾール構造を有する化合物としては イミダゾール、2、4、5-トリフェニルイミダゾー ル、ベンズイミダゾール等があげられる。ジアザビシク 口構造を有する化合物としては1、4-ジアザビシクロ [2, 2, 2] オクタン、1、5-ジアザビシクロ [4, 3, 0] ノナー5ーエン、1、8ージアザビシク 10 ロ[5,4,0]ウンデカー7-エンなどがあげられ る。オニウムヒドロキシド構造を有する化合物としては トリアリールスルホニウムヒドロキシド、フェナシルス ルホニウムヒドロキシド、2-オキソアルキル基を有す るスルホニウムヒドロキシド、具体的にはトリフェニル スルホニウムヒドロキシド、トリス (t - ブチルフェニ ル) スルホニウムヒドロキシド、ビス (t-プチルフェ ニル)ヨードニウムヒドロキシド、フェナシルチオフェ ニウムヒドロキシド、2-オキソプロピルチオフェニウ ムヒドロキシドなどがあげられる。オニウムカルボキシ 20 レート構造を有する化合物としてはオニウムヒドロキシ ド構造を有する化合物のアニオン部がカルボキシレート になったものであり、例えばアセテート、アダマンタン ー1-カルボキシレート、パーフロロアルキルカルボキ シレート等があげられる。トリアルキルアミン構造を有 する化合物としてはトリエチルアミン、トリプチルアミ ン、トリオクチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミ ンなどの無置換アルキルアミン、トリエタノールアミ ン、N-ヒドロキシエチルピペリジンなど水酸基の置換 したアルキルアミンがあげられるがこれらに限定される 30 ものではない。

【0200】本発明に係わるポジ型感光性組成物に於いて、最も好ましい塩基性化合物として、アルキルアミン構造、エーテル結合を有するアルキルアミン構造、水酸基を有するアルキルアミン構造、アニリン構造、ピリジン構造、ジアザビシクロ構造、アンモニウムヒドロキシド構造、アンモニウムカルボキシレート構造及びイミダゾール構造から選ばれる少なくとも1種の構造を有する化合物を挙げることができる。

【0201】これらの(C)塩基性化合物は、単独であ 40 るいは2種以上一緒に用いられる。(C)塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物の固形分を基準として、通常、0.001~10重量%、好ましくは0.01~5重量%である。0.001重量%未満では上記塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0202】≪(D)フッ素系界面活性剤又はシリコン 系界面活性剤≫本発明のポジ型感光性組成物は、フッ素 系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤(フッ素系界面 50

活性剤、シリコン系界面活性剤又はフッソ原子と珪素原 子の両方を含有する界面活性剤)のいずれか、あるいは 2種以上を含有することが好ましい。本発明のポジ型感 光性組成物が上記(D)界面活性剤とを含有することに より、250nm以下、特に220nm以下の露光光源 の使用時に、良好な感度及び解像度で、密着性及び現像 欠陥の少ないレジストパターンを与えることが可能とな る。これらの(D)界面活性剤として、例えば特開昭6 2-36663号、特開昭61-226746号、特開 昭61-226745号、特開昭62-170950 号、特開昭63-34540号、特開平7-23016 5号、特開平8-62834号、特開平9-54432 号、特開平9-5988号、米国特許5405720 号、同5360692号、同5529881号、同52 96330号、同5436098号、同5576143 号、同5294511号、同5824451号記載の界 面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤を そのまま用いることもできる。使用できる市販の界面活 性剤として、例えばエフトップEF301、EF30 3、(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、43 1(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F 173、F176、F189、R08 (大日本インキ (株) 製)、サーフロンS-382、SC101、10 2、103、104、105、106 (旭硝子 (株) 製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株) 製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤 を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーK P-341 (信越化学工業(株) 製) もシリコン系界面 活性剤として用いることができる。

[0203] 界面活性剤の使用量は、ポジ型感光性組成物全量(溶剤を除く)に対して、好ましくは0.0001~2重量%、より好ましくは0.001~1重量%である。

【0204】≪(E)有機溶剤≫本発明のポジ型感光性 組成物は、上記の成分を所定の有機溶剤に溶解して用い る。使用し得る有機溶剤としては、例えば、エチレンジ クロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2 ーヘプタノン、ァープチロラクトン、メチルエチルケト ン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルア セテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセ テート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ト ルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキ シプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、 ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロ ピル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホ キシド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等 を挙げることができる。

【0205】本発明においては、有機溶剤として構造中

に水酸基を含有する溶剤と、水酸基を含有しない溶剤と を混合した混合溶剤を使用することが好ましい。これに よりレジスト液保存時のパーティクル発生を軽減するこ とができる。水酸基を含有する溶剤としては、例えば、 エチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロ ピレングリコール、プロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、乳 酸エチル等を挙げることができ、これらの内でプロピレ ングリコールモノメチルエーテル、乳酸エチルが特に好 10 させないため、Proceeding of SPIE,2724,355 ましい。水酸基を含有しない溶剤としては、例えば、プ ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エ チルエトキシプロピオネート、2-ヘプタノン、γ-ブ チロラクトン、シクロヘキサノン、酢酸プチル、N-メ チルピロリドン、N, N-ジメチルアセトアミド、ジメ チルスルホキシド等を挙げることができ、これらの内 で、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチルエトキシプロピオネート、2-ヘプタノン、 ィープチロラクトン、シクロヘキサノン、酢酸プチルが 特に好ましく、プロピレングリコールモノメチルエーテ 20 ルアセテート、エチルエトキシプロピオネート、2-ヘ プタノンが最も好ましい。水酸基を含有する溶剤と水酸 基を含有しない溶剤との混合比(重量)は、1/99~ 99/1、好ましくは10/90~90/10、更に好

ましくは20/80~60/40である。水酸基を含有 しない溶剤を50重量%以上含有する混合溶剤が塗布均 一性の点で特に好ましい。

【0206】≪(F)酸分解性溶解阻止化合物≫本発明 のポジ型感光性組成物は、(F)酸の作用により分解し てアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基を有し、 分子量3000以下の溶解阻止低分子化合物(以下、 「(F)酸分解性溶解阻止化合物」ともいう)を含有す ることが好ましい。特に220ヵm以下の透過性を低下 (1996)に記載されている酸分解性基を含むコール酸 誘導体の様な、酸分解性基を含有する脂環族又は脂肪族 化合物が(F)酸分解性溶解阻止化合物として好まし い。酸分解性基、脂環式構造としては、(B)成分の酸 分解性樹脂のところで説明したものと同様のものが挙げ られる。(F)酸分解性溶解阻止化合物の分子量は、好 ましくは300~3000、更に好ましくは500~2 500である。(F)酸分解性溶解阻止化合物の添加量 は、ポジ型感光性組成物の全組成物の固形分に対し、好

ましくは3~50重量%であり、より好ましくは5~4

0 重量%である。以下に(F)酸分解性溶解阻止化合物

の具体例を示すが、これらに限定されない。

[0207] 【化78】

50

【0208】≪(G)アルカリ可溶性樹脂≫本発明のポ 30 ジ型感光性組成物は、酸分解性基を含有していない、

(D) 水に不溶でアルカリ現像液に可溶な樹脂を含有す ることができ、これにより感度が向上する。本発明にお いては、分子量1000~2000程度のノボラック 樹脂類、分子量3000~50000程度のポリヒドロ キシスチレン誘導体をこのような樹脂として用いること ができるが、これらは250nm以下の光に対して吸収 が大きいため、一部水素添加して用いるか、又は全樹脂 量の30重量%以下の量で使用するのが好ましい。ま た、カルボキシル基をアルカリ可溶性基として含有する 樹脂も用いることができる。カルボキシル基を含有する 樹脂中にはドライエッチング耐性向上のために単環、又 は多環の脂環炭化水素基を有していることが好ましい。 具体的には酸分解性を示さない脂環式炭化水素構造を有 するメタクリル酸エステルと(メタ)アクリル酸の共重 合体あるいは末端にカルボキシル基を有する脂環炭化水 素基の(メタ)アクリル酸エステルの樹脂などを挙げる ことができる。

【0209】≪その他の添加剤≫本発明のポジ型感光性 組成物には、必要に応じてさらに染料、可塑剤、上記 (D) 成分以外の界面活性剤、光増感剤、及び現像液に対する溶解性を促進させる化合物等を含有させることができる。本発明で使用できる現像液に対する溶解促進性化合物は、フェノール性〇H基を2個以上、又はカルボキシ基を1個以上有する分子量1,000以下の低分子化合物である。カルボキシ基を有する場合は上記と同じ理由で脂環族又は脂肪族化合物が好ましい。これら溶解促進性化合物の好ましい添加量は、(B)酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解速度が増大する樹脂に対して2~50重量%であり、さらに好ましくは5~30重量%である。50重量%を越えた添加量では、現像残渣が悪化し、また現像時にパターンが変形するという新たな欠点が発生して好ましくない。

【0210】このような分子量1000以下のフェノール化合物は、例えば、特開平4-122938、特開平2-28531、米国特許第4916210、欧州特許第219294等に記載の方法を参考にして、当業者において容易に合成することができる。カルボキシル基を有する脂環族、又は脂肪族化合物の具体例としてはコール酸、デオキシコール酸、リトコール酸などのステロイド構造を有するカルボン酸誘導体、アダマンタンカルボ

ン酸誘導体、アダマンタンジカルボン酸、シクロヘキサ ンカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸などが挙げ られるがこれらに限定されるものではない。

【0211】本発明においては、上記(D)フッ素系又 はシリコン系界面活性剤以外の他の界面活性剤を加える こともできる。具体的には、ポリオキシエチレンラウリ ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、 ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレ ンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエ ーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエー 10 テル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等 のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリ オキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリ マー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパ ルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタン モノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタ ントリステアレート等のソルピタン脂肪酸エステル類、 ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオ キシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシ エチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチ 20 レンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソ ルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソル ビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤等を 挙げることができる。これらの界面活性剤は単独で添加 してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加する こともできる。

【0212】≪使用方法≫本発明の感光性組成物は、上 記の成分を所定の有機溶剤、好ましくは前記混合溶剤に 溶解し、次のように所定の支持体上に塗布して用いる。 すなわち、上記感光性組成物を精密集積回路素子の製造 30 に使用されるような基板 (例:シリコン/二酸化シリコ ン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法に より塗布する。塗布後、所定のマスクを通して露光し、 ベークを行い現像する。このようにすると、良好なレジ ストパターンを得ることができる。ここで露光光として は、好ましくは250nm以下、より好ましくは220 nm以下の波長の遠紫外線である。具体的には、KrF エキシマレーザー (248nm)、ArFエキシマレー ザー (193nm)、F₁エキシマレーザー (157n m)、X線、電子ビーム等が挙げられる。ArFエキシ 40 マレーザー (193nm) が最も好ましい。

【0213】現像工程では、現像液を次のように用い る。感光性組成物の現像液としては、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウ ム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アル カリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第一ア ミン類、ジエチルアミン、ジーnープチルアミン等の第 ニアミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン 等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエ タノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチル 50 ロロベンセンスルホネート(具体例(IA-9)、 (1)

アンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウム ヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピ ヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用 することができる。さらに、上記アルカリ性水溶液にア ルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用すること もできる。

[0214]

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説 明するが、本発明の範囲は実施例によっていささかも制 限されない。

【0215】〔(A)成分である光酸発生剤の合成〕 (ペンタフロロベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモ ニウム塩の合成)ペンタフロロペンセンスルホニルクロ リド25gを氷冷下メタノール100m1に溶解させ、 これに25%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水 溶液100gをゆっくり加えた。室温で3時間撹伴する とペンタフロロベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモ ニウム塩の溶液が得られた。この溶液をスルホニウム 塩、ヨードニウム塩との塩交換に用いた。

【0216】(トリフェニルスルホニウムペンタフロロ ベンセンスルホネートの合成:具体例(IA-1)の合 成) ジフェニルスルホキシド50gをベンゼン800m 1に溶解させ、これに塩化アルミニウム200gを加 え、24時間還流した。反応液を水2Lにゆっくりと注 ぎ、これに濃塩酸400m1を加えて70℃で10分加 熱した。この水溶液を酢酸エチル500m1で洗浄し、 ろ過した後にヨウ化アンモニウム200gを水400m 1に溶解したものを加えた。析出した粉体をろ取、水洗 した後酢酸エチルで洗浄、乾燥するとトリフェニルスル ホニウムヨージドが70 g得られた。トリフェニルスル ホニウムヨージド30.5gをメタノール1000m1 に溶解させ、この溶液に酸化銀19.1gを加え、室温 で4時間撹伴した。溶液をろ過し、これに過剰量の上記 で合成したペンタフロロベンゼンスルホン酸テトラメチ ルアンモニウム塩の溶液を加えた。反応液を濃縮し、こ れをジクロロメタン500m1に溶解し、この溶液を5 %テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液、及び 水で洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、 濃縮するとトリフェニルスルホニウムペンタフロロベン センスルホネートが得られた。

【0217】 (トリアリールスルホニウムペンタフロロ ベンセンスルホネートの合成:具体例(IA-9)と (川A-1) との混合物の合成) トリアリールスルホニ ウムクロリド50g (Fluka製、トリフェニルスルホニ ウムクロリド50%水溶液)を水500m1に溶解させ これに過剰量のペンタフロロベンゼンスルホン酸テトラ メチルアンモニウム塩の溶液を加えると油状物質が析出 してきた。上澄みをデカントで除き、得られた油状物質 を水洗、乾燥するとトリアリールスルホニウムペンタフ

(51)

100

A-1) を主成分とする) が得られた。

【0218】 (ジ(4-t-アミルフェニル) ヨードニ ウムペンタフロロベンセンスルホネートの合成:具体例 (IIIA-1) の合成) t-アミルペンゼン60g、ヨ ウ素酸カリウム39.5g、無水酢酸81g、ジクロロ メタン170m1を混合し、これに氷冷下濃硫酸66. 8gをゆっくり滴下した。氷冷下2時間撹伴した後、室 温で10時間撹伴した。反応液に氷冷下、水500m1 を加え、これをジクロロメタンで抽出、有機相を炭酸水 素ナトリウム、水で洗浄した後濃縮するとジ(4-t-アミルフェニル) ヨードニウム硫酸塩が得られた。この 硫酸塩を、過剰量のペンタフロロベンゼンスルホン酸テ トラメチルアンモニウム塩の溶液に加えた。この溶液に 水500m1を加え、これをジクロロメタンで抽出、有 機相を5%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶 液、及び水で洗浄した後濃縮するとジ(4-t-アミル フェニル) ヨードニウムペンタフロロベンセンスルホネ ートが得られた。その他の化合物についても同様の方法 を用いることで合成できる。

99

【0219】〔(B)成分である樹脂の合成〕

合成例1 (樹脂(1)の合成)

2-メチル-2-アダマンチルメタクリレートと、6-e n d o -ヒドロキシビシクロ $\{2.2.1\}$ ヘプタン-2-e n d o -カルボン酸 $-\gamma-$ ラクトンの5-e x o -メタクリレートとをモル比50/50の割合で仕込み、N,N-ジメチルアセトアミド/テトラヒドロフラン=5/5に溶解し、固形分濃度20%の溶液100m 1を調整した。6-en d o -ヒドロキシビシクロ $\{2.2.1\}$ ヘプタン-2-en d o -カルボン酸 -

【2. 2. 1】ヘプタン-2-endo-カルボン酸- γ -ラクトンの5-exo-メタクリレートは、6-e 30 ndo-ヒドロキシピシクロ〔2. 2. 1】ヘプタン-2-endo-カルボン酸をアセトキシーラクトン化した後、アセトキシ基をヒドロキシ基にアルカリ加水分解し、更にメタクリル酸クロリドでエステル化することに

より合成したものを用いた。 J. Chem. Soc., 227 (1959)、 Tetrahedron, 21, 1501 (1965) 記載の方法によった。この溶液に和光純薬工業製V-65を3mol%加え、これを窒素雰囲気下、3時間かけて60℃に加熱したN, N-ジメチルアセトアミド10mlに滴下した。滴下終了後、反応液を3時間加熱、再度V-65を1mol%添加し、3時間撹拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留水3Lに晶析、析出した白色粉体を回収した。C''NMRから求めたポリマー組成は51/49であった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は7, 200であった。上記合成例と同様にして、樹脂(2)~(19) を合成した。 [0220] 以下、樹脂(1)~(19) の構造を示す。

[0221][化79]

$$-(CH_{2}-C)\frac{CH_{3}}{m} -(CH_{2}-C)\frac{CH_{3}}{m} -(CH$$

$$-(CH_2-C)\frac{CH_3}{m}$$

$$-(CH_2-C)\frac{CH_3}{m}$$

$$O^{C}-O$$

$$CH_3$$

$$O^{C}-O$$

$$H_3C$$

$$O^{C}$$

$$O^{C}$$

[0222] [化80]

[0223]

[(E 8 1)]

$$CH_3$$
 CH_2
 CH_3
 CH_2
 CH_3
 CH_2
 CH_3
 C

[0229]

[0231]

$$CH_3$$
 CH_3
 CH_3

[0 2 3 3]

(CH₂-C
$$\frac{CH_3}{m}$$

(CH₂-C $\frac{CH_3}{m}$

(17)

(18)

(19)

【0235】表1に樹脂(1)~(19)の繰り返し単位のモル比(各樹脂例で示した繰り返し単位と左から順に対応)及び重量平均分子量を示す。

[0236]

【表1】

表1

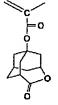
~9

衣 1		
樹脂	組成比(モル比)	重量平均分子量
(1)	51/49	7200
(2)	40/60	11300
(3)	50/15/15/20	6400
(4)	52/48	8500
(5)	35/65	14500
(6)	50/50	10500
(7)	49/51	7600
(8)	49/31/20	12500
(9)	30/50/20	10300
(10)	35/55/10	14600
(11)	40/40/20	13700
(12)	35/65/10	5600
(13)	40/60	9300
(14)	47/45/8	8900
(15)	50/45/5	7100
(16)	45/50/5	13200
(17)	40/50/10	6900
(18)	40/20/40	12300
(19)	40/20/40	10500

2-メチルー2-アダマンタンメタクリレート、下記モノマーを40/60のモル比で仕込みメチルエチルケトン/テトラヒドロフラン=5/5に溶解し、固形分濃度20%の溶液100mLを調製した。この溶液に和光純薬製V-65を2mol%mえ、これを窒素雰囲気下、4時間かけて60℃に加熱したメチルエチルケトン10mLに滴下した。滴下終了後、反応液を4時間加熱、再度V-65を1mol%添加し、4時間撹拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留水/1SOプロピルアルコール=1/1の混合溶媒3Lに晶析、析出した白色粉体である樹脂(20)を回収した。

[0238]

[化93]

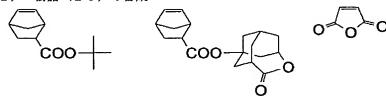


20 【0239】合成例(3) 樹脂(31)の合成 下記モノマー(左から順にモル比30/20/50) およびTHF(反応濃度60重量%)をセパラブルフラスコに仕込み、窒素気流下60℃で加熱した。反応温度が安定したところで和光純薬社製ラジカル開始剤V-601を2mol%加え反応を開始させた。12時間加熱した。得られた反応混合物をテトラヒドロフランで2倍に稀釈した後、ヘキサン/イソプロピルアルコール=1/1の混合溶液に投入し白色粉体を析出させた。析出した粉体を濾過取り出しし、乾燥、目的物である樹脂(3

30 1)を得た。 【0240】

【化240

【0237】合成例(2) 樹脂(20)の合成



【0241】上記と同様にして樹脂(21)~(3

0)、樹脂(32)~(39)及び比較例用樹脂(4

0)を合成した。以下、樹脂(20)~(40)の構造

40 を示す。 【0242】 5 【化95】

(20)

[0243]

[0 2 4 4]

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
-(CH_{2}-C) \\
-$$

[0246]

[0247]

【化100】

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ COO \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (33) \\ (34) \\ (34) \\ (35) \\ (3$$

[0250] 【化103】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ &$$

[0251]

【化104】

【0252】下記表2に樹脂(20) \sim (40) の繰り返し単位のモル比(各樹脂例で示した繰り返し単位と左から順に対応)、分子量を示す。

[0253]

【表2】

表 2

	繰り返し単	扱り短1単	繰り返し単	繰り返し単	分子母
	位1 (mol%)	位 2 (mol%)	位3(mol%)	位 4 (mol%)	77 1 <u>ac</u>
(20)	4 0	60			12300
(21)	40	40	20		8300
(22)	30	5 0	20		7000
(23)	40	40	20		19800
(24)	40	50	10		9100
(25)	30	20	20	30	6900
(26)	20	20	4 0	20	9300
(27)	5 0	40	10		5600
(28)	25	30	30	1 5	7700
(29)	30	30	30	10	11100
(30)	40	40	10	1 0	8900
(31)	30	20	50		7400
(32)	25	25	50		10200
(33)	40	10	50		4900
(34)	25	25	40	10	6000
(35)	40	40	20		9300
(36)	40	3 5	20	5	7600
(37)	25	25	50		6500
(38)	30	30	2 0	20	9800
(39)	2 5	25	30	20	9800
(40)	50	5 0			5500

【0254】〔実施例1~39及び比較例1~2〕 <レジスト調整>表3~6に示す素材を溶解させ固形分 濃度12%の溶液を調整し、これを0.1μmのテフロ

製した。調製した組成物を下記方法で評価を行い、結果 を表7~8に示した。

[0255]

[表3]

表 3						
	樹脂	酸発生剤	塩基性	界面	溶剤	その他
ŀ	(10g)	(g)	化合物	活性剤	(重量比)	(g)
			(g)	(0.03g)		
実施例	(1)	IA-1 (0, 15)	DBN	¥-1	A1=100	
1	Ì		(0.02)			
実施例	(2)	IA-5 (0. 2)	TBAH	W-1	A1=100	
2			(0.02)			ļ
実施例	(3)	TA-6 (0. 1)	TPI	₩-2	A1=100	
3			(0.01)			
実施例	(4)	IA-8 (0. 15)	TPSA	₩-2	A3/B2	
4			(0.015)		=80/20	
実施例	(5)	1A-15(0.1)	HEP	₩-3	A2/B1	
5		Z1 (0. 05)	(0.015)		=90/10	
実施例	(6)	IA-17 (0. 1)	DCMA	W-3	A4/B1	LCB
6		Z2 (0. 1)	(0.02)		=90/10	(1)
実施例	(7)	IA-18(0.05)	TPA	W-4	A1/B1	
7		Z6 (0. 1)	(0.01)		=50/60	
実施例	(8)	IA-19 (0.05)	TOA	₩-4	A1/B1	
8		213 (0. 15)	(0.02)		=90/10	
実施例	(9)	1A-20 (0. 05)	TBA	₩-1	A5/B2	
9		230 (0. 15)	(0.01)		=90/10	1
実施例	(10)	LA-21 (0. 1)	HAP	H-1	A1/B1	
10		Z16(0. 1)	(0.015)	İ	=95/5	

117

表4

26.4						
	樹脂	酸発生剤	塩基性	界面	溶剤	その他
	(10g)	(g)	化合物	活性剤	(重量比)	(g)
			(g)	(0.03g)		
実施例	(11)	1A-22(0.1)	TBA	N-2	A1/B1	
11		Z21(0.3)	(0.03)		=90/10	
実施例	(12)	1A-24(0.1)	DIPA	W-2	A1/BI	
12		Z22(0.1)	(0.01)		=95/5	
実施例	(13)	13A-1(0.1)	TMEA	W-3	A1/B1	
13		Z34(0.1)	(0.01)		=95/5	
実施例	(14)	I11A-1(0.05)	TBA	₩-3	A1/B1	
14		Z31(0.15)	(0.005)		=95/5	
実施例	(15)	IVA-4(0.1)	DIPA	₩-4	A1/B1	
15		21(0.1)	(0.01)		=80/20	
実施例	(16)	VIA-2(0.1)	TPI	¥-4	A1	
16		Z2(0.1)	(0.01)		=100	
実施例	(17)	IA-17(0.05)	TPSA	W-4	A1	
17		Z33(0.1)	(0.02)		=100	
		Z42(0.1)				
実施例	(18)	IA-20(0.05)	HEP	W-4	A1	
18		Z33(0.15)	(0.03)		=100	
実施例	(19)	IA-21(0.1)	DCHA	W-4	A1/B1	
19		233(0.1)	(0.02)		=95/5	
実施例	(20)	IA-18(0.02)	TPA	W-4	AL/B1	
20		233(0.1)	(0.015)		=95/5	
		Z36(0.1)				

[0257]

【表5】

		[23]				
表 5	1					
	樹脂	酸発生剤	塩基性	界面	溶剤	その他
	(10g)	(g)	化合物	活性剤	(重量比)	(g)
			(g)	(0.03g)		
実施例	(21)	IA-23 (0. 01)	TOA	W-1	A1/B1	
21		243 (0. 4)	(0. 02)		=95/5	
実施例	(22)	IA-13 (0. 05)	TBA	W-1	A1/B1	
22		Z33 (0. 05)	(0.005)		=80/20	
	(= -)	242 (0. 3)			11.57	
実施例	(23)	IA-15 (0.075)	HAP	₩-2	A1/B1	
2 3	42.13	Z31 (0. 3)	(0.01)		=90/10	
実施例	(24)	IA-7 (0. 05)	TBA	₩~2	A3/B2	
2 4		233 (0, 1) 226 (0, 1)	(0.01)		≃80/20	
実施例	(25)	IA-20(0.1)	DBN	W-1	A1=100	
25	(20)	229 (0. 1)	(0. 02)	" •	200	
実施例	(26)	IA-22 (0.02)	ТВАН	W-1	A1=100	
26		233 (0. 1)	(0.02)			
		Z7 (0. 05)				
実施例	(27)	IA-19(0.1)	TPI	¥-2	A1=100	
27		Z8 (0, 1)	(0.01)			
実施例	(28)	IA-20 (0, 2)	TPSA	W-2	A3/B2	
28		Z12 (0. 05)	(0.015)		=80/20	
実施例	(29)	IA-17 (0. 01)	HEP	₩-3	A2/B1	
29		Z6 (0. 1)	(0, 015)		=90/10	
実施例	(30)	IA-7 (0, 1)	DCMA	W-3	A4/B1	LCB
3 O		Z13 (0. 1)	(0.02)		=90/10	(1)

表的

₹ U						
	樹脂	酸発生剤	塩基性	界面	溶剤	その他
	(10g)	(g)	化合物	活性剤	(重量比)	(g)
			(g)	(0.03g)		
実施例	(31)	IA-18(0.03)	TPA	W-4	A1/B1	
31		Z33(0.1)	(0.01)		=50/50	
		216(0.05)				
実施例	(32)	IA-19(0.1)	TOA	W-4	AL/B1	
3 2		Z38(0.3)	(0.02)		=90/10	
実施例	(33)	IA-20(0.05)	TBA	W-1	A5/B2	
33		Z30(0.4)	(0.01)		=90/10	
実施例	(34)	IA-21(0.05)	HAP	W-1	AL/B1	
34		Z33(0.1)	(0.015)		=95/5	
実施例	(35)	IA-20(0.1)	TBA	W-2	A1/B1	
35		722(0.1)	(0.03)		=90/10	
実施例	(36)	IA-17(0.2)	DIPA	W-2	A1/B1	
3 6		Z33(0.05)	(0.01)		=95/5	
実施例	(37)	IA-20(0.05)	THEA	₩-3	A1/B1	
37		Z33(0.1)	(0.01)		=95/5	
		242(0.2)				
実施例	(88)	IA-1(0.15)	TBA	¥ -3	A1/B1	
38			(0.005)		=95/5	
実施例	(39)	IA-5(0.2)	DIPA	V-4	A1/B1	
39			(0.01)		=80/20	
比較例	(40)	IA-1(0.15)	DBN	A-1	A1	
1			(0.02)		=100	
比較例	(1)	Z1(0.15)	DBN	W-1	A1	
2			(0.02)		=100	

【0259】 (表3~6に於ける略号の説明)

DBN; 1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0] ノナー 5 -エン

TPI; 2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール

TPSA: トリフェニルスルホニウムアセテート

HEP: N-ヒドロキシエチルピペリジン

DCMA: ジシクロヘキシルメチルアミン

TPA; トリペンチルアミン

TOA:トリーn-オクチルアミン

TBA; トリーn ープチルアミン

HAP:ヒドロキシアンチピリン

TBAH; テトラプチルアンモニウムヒドロキシド

TMEA; トリス (メトキシエトキシエチル) アミン

DIPA; 2, 6-ジイソプロピルアニリン

LCB;リトコール酸 t ープチル

W-1;メガファックF176 (大日本インキ (株)

製) (フッ素系)

W-2; メガファックR08 (大日本インキ (株) 製) (フッ素及びシリコン系)

W-3;ポリシロキサンポリマーKP-341(信越化 学工業 (株) 製) (シリコン系)

W-4;トロイゾルS-366(トロイケミカル(株) 製)

【0260】A1;プロピレングリコールメチルエーテ ルアセテート

A2:2-ヘプタノン

A3;エチルエトキシプロピオネート

A4; ァープチロラクトン

A5;シクロヘキサノン

30 B1;プロピレングリコールメチルエーテル

B2: 乳酸エチル

【0261】 〈画像評価法〉スピンコーターにてヘキサ メチルジシラザン処理を施したシリコン基板上にプリュ ーワーサイエンス社製反射防止膜ARC25を600オ ングストローム均一に塗布し、100℃で90秒間ホッ トプレート上で乾燥した後、190℃で240秒間加熱 乾燥を行った。その後、各感光性樹脂組成物をスピンコ ーターで塗布し120℃で90秒乾燥を行い0.30 µ mのレジスト膜を形成させた。このレジスト膜に対し、 40 マスクを通してArFエキシマレーザーステッパー(I S I 社製 NA= 0. 6) で露光し、露光後直ぐに12 0℃で90秒間ホットプレート上で加熱した。さらに 2. 38%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶 液で23℃で60秒間現像し、30秒間純水にてリンス した後、乾燥し、ラインパターンを得た。

〔解像力〕: 露光直後に加熱、現像処理を行ったときの 0. 18μ mのラインアンドスペース(1:1)マスク パターンを再現する露光量における限界解像力を解像力 1とし、露光後2時間経時した後加熱、現像処理を行

50 い、上記と同一露光量における限界解像力を解像力2と

した。

〔粗密依存性〕:線幅 0. $18 \mu m$ のラインアンドスペースパターン(密パターン:ラインアンドスペース 1/2 1)と孤立ラインパターン(疎パターン:ラインアンドスペース 1/2 5)に於いて、それぞれ 0. $18 \mu m \pm 1$ 0%を許容する焦点深度の重なり範囲を求めた。

[0262]

【表7】

表 7

数 7			
実施例	解像力1	解像力2	粗密依存性
	(μm)	(μm)	(ma)
1	0.105	0.105	7. 6
2	0.105	0.105	5. 2
3	0.110	0.110	8.8
4	0.105	0.105	10.3
5	0. 110	0.110	6.2
6	0.110	0.110	7.3
7	0.105	0.105	9. 7
8	0.110	0.110	8. 2
9	0.105	0.105	5. 1
10	0.110	0.110	6. 9
11	0.110	0.110	8. 7
1 2	0.105	0.105	9. 7
1 3	0.105	0.105	5. 3
1 4	0.105	0.105	7. 9
1 5	0.110	0.110	8.3
1 6	0.105	0.105	5.8
1 7	0.110	0.110	7. 3
18	0.105	0.105	9. 5
19	0. 110	0.110	10.4
2 0	0.105	0.105	9. 8
2 1	0.105	0.105	7. 4
2 2	0.110	0.110	7. 9
23	0.105	0. 105	5. 3
2 4	0. 110	0.110	8. 6
2 5	0.110	0.110	9. 2

[0263]

【表 8 】

表 8

実施例	解像力1	解像力2	粗密依存性
	(μm)	(μm)	(nm)
26	0.110	0.110	5. 5
2 7	0.105	0.105	9. 5
28	0.110	0.110	5.8
2 9	0.105	0.105	8. 0
3 0	0.105	0.105	10.3
3 1	0.110	0.110	9. 4
3 2	0.110	0.110	7. 0
3 3	0.110	0.110	5. 2
3 4	0.105	0.105	10.5
35	0.110	0.110	8.4
36	0.105	0.105	5.9
37	0.110	0.110	7. 5
38	0.105	0.105	7. 2
3 9	0.105	0.105	8. 2
比較例	解像力1	解像力2	粗密依存性
	(μm)	(µm)	(nm)
1	0.130	0.140	16.0
2	0.120	0.150	22.0

【0264】表7~8から、本発明に係わるポジ型感光性組成物は、解像力に優れ、レジスト膜に露光した後に後加熱までに時間が経過しても解像力が低下することがなく、且つ疎密依存性に優れていることが明らかである。

30 [0265]

【発明の効果】本発明により、解像力に優れ、レジスト 膜に露光した後に後加熱までに時間が経過しても解像力 が低下することがなく、且つ疎密依存性に優れたポジ型 感光性組成物を提供することができる。